



- (51) 국제특허분류:
H01L 23/60 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2015/003750
- (22) 국제출원일: 2015 년 4 월 15 일 (15.04.2015)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2014-0127067 2014 년 9 월 23 일 (23.09.2014) KR
- (71) 출원인: 제너셈(주) (GENESEM INC.) [KR/KR]; 402-835 인천시 남구 염전로 316, Incheon (KR).
- (72) 발명자: 한복우 (HAN, Bok-Woo); 406-700 인천시 연수구 센트럴로 232, 101 동 2804 호, Incheon (KR). 이희동 (LEE, Hee-Dong); 404-170 인천시 서구 청라커널로 163, 486 동 1904 호, Incheon (KR).
- (74) 대리인: 윤영한 (YUN, Young-Han); 407-784 인천시 계양구 계산새로 71, 하이베라스빌딩 D 동 1010 호, Incheon (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO,

AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

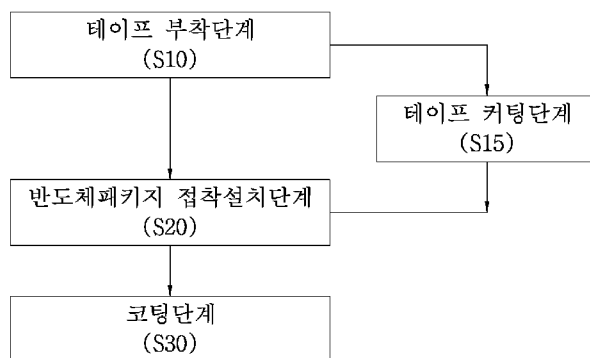
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))

(54) Title: METHOD FOR TREATING SEMICONDUCTOR PACKAGE WITH EMI SHIELD

(54) 발명의 명칭 : 반도체패키지의 이엠아이 쉴드 처리방법



S10 ... Tape attachment step

S15 ... Tape cutting step

S20 ... Semiconductor package gluing/installing step

S30 ... Coating step

(57) Abstract: The present invention relates to a method for treating a semiconductor package with an EMI shield, the method comprising: a tape attachment step for attaching the periphery of a tape to the lower surface of a frame so as to form a tape on the inner periphery of the frame; a tape cutting step for forming holes on the tape at a predetermined interval; a semiconductor package gluing/installing step for arranging the periphery of the lower surface of the semiconductor package on the upper surface of the tape such that bumps, which are formed on the lower surface of the semiconductor package, are fitted to the holes of the tape, thereby gluing/installing the semiconductor package on the upper surface of the tape at a predetermined interval; and a coating step for conducting a coating operation on the upper portion of the tape such that the semiconductor package, which is glued to the upper surface of the tape, and the upper surface of the tape are treated with a coating, the method being characterized in that, except the lower surface of the semiconductor package, five surfaces are coated.

(57) 요약서:

[다음 쪽 계속]



본 발명은 반도체패키지의 이엠아이 쉴드 처리공법에 관한 것으로, 프레임의 하면에 테이프의 가장자리를 부착하여 프레임의 내주에 테이프를 형성시키는 테이프 부착단계; 상기 테이프에 홀을 일정간격으로 형성시키는 테이프 커팅단계; 반도체패키지의 하면에 형성된 범프가 테이프의 홀에 끼워지도록 반도체패키지의 하면 가장자리를 테이프의 상면에 배치하여 상기 반도체패키지를 테이프의 상면에 일정간격으로 접착설치하는 반도체패키지 접착설치단계; 상기 테이프의 상부에서 코팅작업 하여 테이프의 상면에 접착된 반도체패키지와 테이프의 상면을 코팅처리하는 코팅단계;로 구성되어, 반도체패키지의 하면을 제외한 5면 코팅이 이루어지는 것을 특징으로 한다.